

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 2 区分

【発行日】平成 16 年 9 月 9 日 (2004.9.9)

【公開番号】特開 2001-316397 (P2001-316397A)

【公開日】平成 13 年 11 月 13 日 (2001.11.13)

【出願番号】特願 2001-145749 (P2001-145749)

【国際特許分類第 7 版】

C 07 H 15/18

A 61 P 35/00

A 61 P 37/02

C 07 H 15/10

【F I】

C 07 H 15/18

A 61 P 35/00

A 61 P 37/02

C 07 H 15/10

【手続補正書】

【提出日】平成 15 年 8 月 28 日 (2003.8.28)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

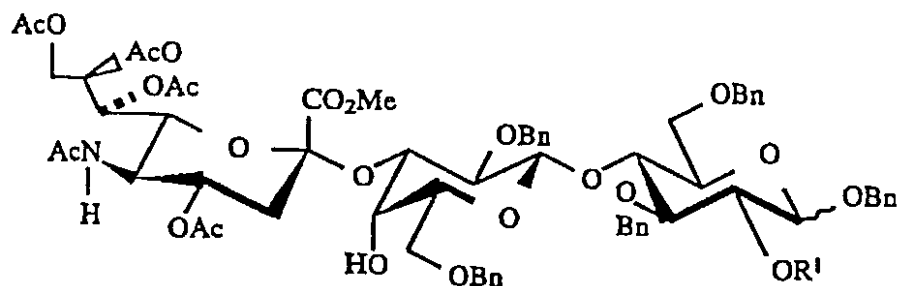
【補正の内容】

【特許請求の範囲】

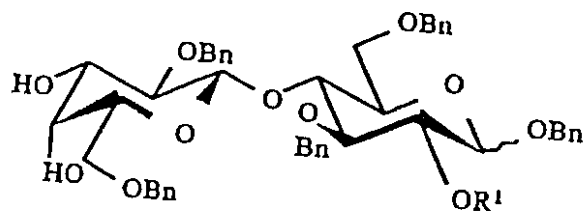
【請求項 1】

化 1 に記載のモノシアロガングリオシド化合物を作る方法であって、化 2 に記載の化合物と化 3 に記載の化合物とを、触媒の存在下で反応させて前記モノシアロガングリオシド化合物を形成させることからなり、ここで、化 1 および化 2 における R¹は、ベンジルまたはピバロイルであり、化 3 における R は、エチルである、化 1 に記載のモノシアロガングリオシド化合物を作る方法。

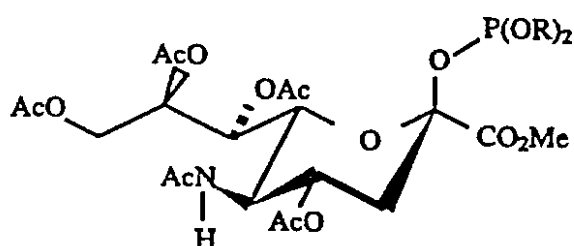
【化 1】



【化 2】



【化 3】



【請求項 2】

前記触媒がトリフルオロメタンスルホン酸塩である、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 3】

前記トリフルオロメタンスルホン酸塩が金属トリフルオロメタンスルホン酸塩である、請求項 2 に記載の方法。

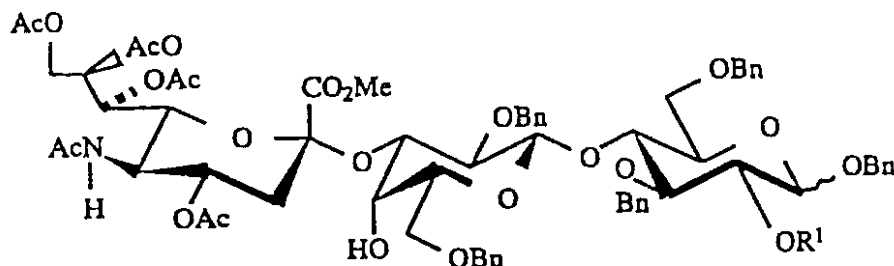
【請求項 4】

前記金属トリフルオロメタンスルホン酸塩が、トリフルオロメタンスルホン酸スズ (II)、トリフルオロメタンスルホン酸イッテルビウム (III)、トリフルオロメタンスルホン酸銅 (II)、および、トリフルオロメタンスルホン酸銀 (I) からなるグループから選択される、請求項 3 に記載の方法。

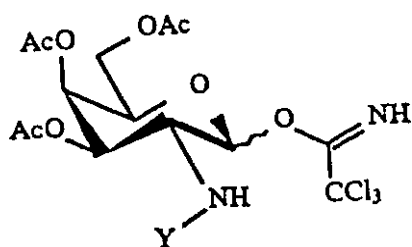
【請求項 5】

以下の (a) ~ (e) の工程：(a) 化 4 に記載の化合物と 化 5 に記載の化合物とを反応させて 化 6 に記載の化合物を形成させる工程、ここで、化 4 および 化 6 における R¹ は、ベンジルまたはピバロイルであり、化 5 および 化 6 における Y は、電子吸引基である、

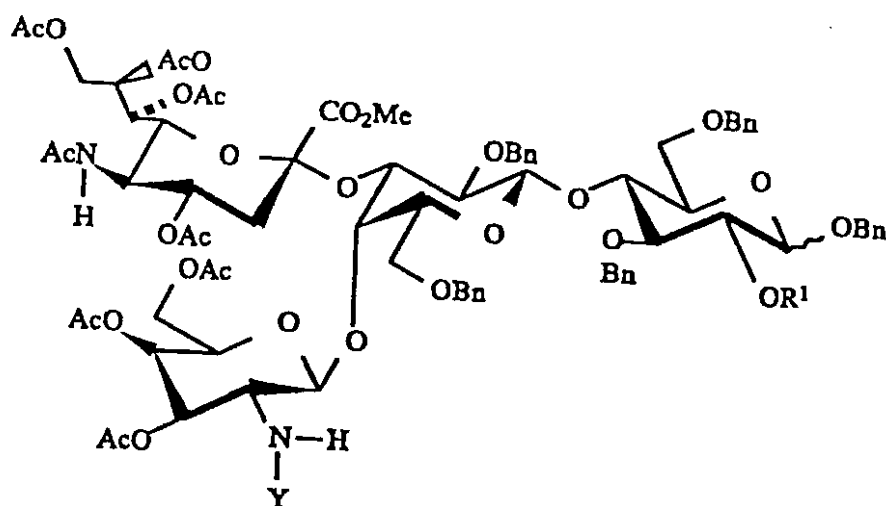
【化 4】



【化 5】



【化 6】



(b) 前記電子吸引基をアセチル基によって置換する工程、(c) 工程(b)において形成された化合物からO-ベンジル基を除去する工程、(d) 工程(c)において形成された化合物をO-アセチル化する工程、そして、(e) 工程(d)において形成された化合物をGM2へと変換する工程、を有する、モノシアロガングリオシドGM2を合成する方法。

【請求項 6】

Yが、2,2,2-トリクロロエトキシカルボニル、2,2,2-トリブromoエトキシカルボニル、2,2,2-トリフルオロエトキシカルボニル、および、4-ニトロフェニルエトキシカルボニルからなるグループから選択される、請求項5に記載の方法。

【請求項 7】

前記電子吸引基が、2,2,2-トリクロロエトキシカルボニルである、請求項5に記載の方法。

【請求項 8】

前記化合物を無水酢酸中の亜鉛による原位置(in situ)処理によって、前記電子吸引基を除去する工程を有する、請求項5に記載の方法。

【請求項 9】

Yが、トリブromoアセチル基、トリクロロアセチル基、およびトリフルオロアセチル基からなるグループから選択される、請求項5に記載の方法。

【請求項 10】

Yが、トリクロロアセチル基である、請求項9に記載の方法。